



উল্লেখ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	M156-54-PERC			
হিলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		STC				
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডবলউপা	270	275	280	285
শকত নিরীবাচন	[Pmpp]	ডবলউপা	0/+5			
ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোল্টেজ	30,03	30,19	30,35	30,62
কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পায়ার	8,99	9,10	9,22	9,30
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ	[Voc]	ভোল্টেজ	36,52	36,68	36,82	37,03
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পায়ার	9,42	9,60	9,75	9,84
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ	[Vsyst]	ভোল্টেজ	1500 / 1000			
ম্যাক্সিমাম সার্কিট ফ্রিকুয়েন্সি	[Icf]	অ্যাম্পায়ার	15			
এফসিয়েন্স	[ηm]	%	18,39	18,71	19,06	19,40
ফরম ফ্যাক্টর	[FF]	%	78,48	78,02	77,95	78,15
হিলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		NMOT				
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডবলউপা	199	202	206	210
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোল্টেজ	27,34	27,49	27,63	27,88
ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পায়ার	7,30	7,39	7,49	7,55
কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Voc]	ভোল্টেজ	33,38	33,53	33,65	33,85
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পায়ার	7,64	7,79	7,91	7,98
ম্যাকানিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
সাইজ	(X)	এমএম	992			
	(Y)	এমএম	1480			
	(Z)	এমএম	8			
	(অঞ্চল)	m2	1,47			
ওজন		কাজী	25,82			
সামন		উপাদান	Glass			
এনক্যাপসুলেশন		এমএম	3,2			
		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,38			
কোষ		মডেল	mono (sc-Si)			
		সাইজ	156,75 x 156,75			
		ম্যাট্রিক্স কুয়ান্টিটি	6 x 9			
এনক্যাপসুলেশন		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,38			
		উপাদান	Glass			
বিয়ার		এমএম	3,2			
		উপাদান	Glass			
জংশন বক্স						
সুরক্ষা	Grade	IP	65			
ভায়োডেস (বাইপাস)	Bypass	কুয়ান্টিটি	4			
ক্যাবলস	(+/ -)	কুয়ান্টিটি	2			
		দৈর্ঘ্য	900			
		অধায়	4			
কানেক্টরস	(+/ -)	মডেল	MC-T4			
		কুয়ান্টিটি	2			
থার্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
তাপমাত্রা সহগ অব শর্ট সার্কিট কারেন্ট α	[Isc]	%/°C	0,0814			
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ β	[Voc]	%/°C	-0,391			
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার γ	[Pmpp]	%/°C	-0,5141			
তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Impp]	%/°C	0,1			
তাপমাত্রা সহগ অব ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	%/°C	-0,38			
নামমাত্রা মডেল অপর্যাপ্ত তাপমাত্রা	[NMOT]	°C	47±2			
টলারেন্স						
ওয়ারিং টেম্পারেচার		°C	-40/+85			
ভাইলেকট্রিক ইন্সোলেশন ভোল্টেজ		V/DC	3000			
রিলিটিভ হিউমিডিটি		%	0/+100			
ওয়ারিং রেসিস্ট্যান্স		Pa	2400			
ম্যাকানিক্যাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি		Pa	8000			
সর্বধিক শালার্বা প্রতারণা		∅	28			
		m/s	23			
স্থল পরিবাহিতা		Ω	≤ 0,1			
সহ্য করার কক্ষমতা		Ω	≥ 100			
শ্রেণীবিভাগ						
আবদন		ক্লাস	A			
নিরাপত্তা		ক্লাস	II			
ফায়ার রেসিস্ট্যান্স		ক্লাস	A			
দহন		ডিজিট	1			
উপাদান		পূরণ	I			
সুরক্ষা		কারণ	1.5			
গ্যারান্টি						
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস		ইয়ারস	12			
কর্মক্ষমতা	90% রটে পাওয়ার কক্ষমতা	ইয়ারস	12			
	80% রটে পাওয়ার কক্ষমতা	ইয়ারস	25			
বর্ণনা						
সিলিকন সেল ফোটোভোলটাইক সের মডিউল mono (sc-Si), বিআইপিভি-কাচ/কাচ সিরিজ, স্থাপত্য ইন্টিগ্রেশন জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Wp) 270-285 W, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Vmpp) 30,03-30,62 V, ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Imp) 8,99-9,30 A, কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 36,52-37,03 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 9,42-9,84 A, এফসিয়েন্স 18,39-19,40 %, নিয়ে গঠিত 54 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, কাচের এনক্যাপসুলেশন স্তর EVA, পিছনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, জংশন বক্স (ভায়োডেস, ক্যাবলস 4 এমএম, 900 এমএম এবং কানেক্টরস MC-T4), ওয়ারিং টেম্পারেচার -40/+85 °C, মাত্রা 992x1480 এমএম, ওয়াইন্ড রেসিস্ট্যান্স 2400 Pa, ম্যাকানিক্যাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 8000 Pa, ওজন 25,82 কেজি						